# FORMATION OF HARD CARBON COATING FILM AND ELECTRIC SHAVER EDGE

Publication number: JP10088369

Publication date: 1998-04-07

Inventor:

DOMOTO YOICHI; HIRANO HITOSHI; KURAMOTO

KEIICHI; KIYAMA SEIICHI

Applicant:

SANYO ELECTRIC CO

Classification:

international:

B26B19/00; C23C16/02; C23C16/26; C23C16/27; C23C16/511; C23C28/00; C30B29/04; B26B19/00; C23C16/02; C23C16/26; C23C16/50; C23C28/00; C30B29/04; (IPC1-7): C23C28/00; B26B19/00;

C23C16/02; C23C16/26; C30B29/04

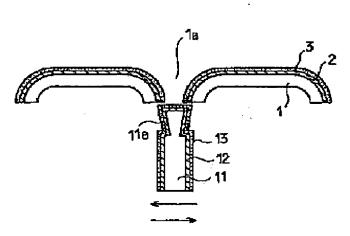
- European:

Application number: JP19960236728 19960906 Priority number(s): JP19960236728 19960906

Report a data error here

## Abstract of JP10088369

PROBLEM TO BE SOLVED: To uniformly form an intermediate layer even to a substrate having a three dimensional shape and to improve the adhesion of hard carbon coating film to be formed thereon by forming the intermediate layer on the substrate by plating. SOLUTION: As an example having a substrate with a complicated three dimensional shape. the edge of an electric shaver can be given. On the substrate 1 of the outer edge of the shaver edge, an intermediate layer 2 is formed on the intermediate layer 2. Then, on this intermediate layer 2, diamond like coating film 3 is formed as hard carbon coating film. The inside of the substrate 1 of the outer edge is provided with an inner edge. Diamond like coating film 13 is formed on an intermediate layer 12 formed by plating. A gradient face 11a for shortly cutting mustaches is formed on the tip part of the substrate 11 of the inner edge. Then, the substrate 1 of the outer edge may be formed of Ni or the like, and the substrate 11 of the inner edge may be formed of a stainless steel or the like.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-88369

(43)公開日 平成10年(1998)4月7日

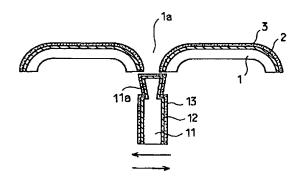
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号		FΙ							٧.	
C 2 3 C	28/00			C 2	3 C	28/00				в		
B 2 6 B	19/00			B 2	6 B	19/00			,	В		
	,					,				D		
C 2 3 C	16/02	•		C 2	3 C	16/02			•	_		
	16/26			02		16/26						
	10/20		数水类	-t: \$4+B	<del>0</del> ±4-₽		<b>~</b> t	/۸	,, ·	P4*\	EL +0 75 100	خر ماورد
			各国明水	不明水	四水	項の数9	OL	Œ	٠.	貝/	最終頁に	好く
(21)出願番号	<b>.</b>	特願平8-236728		(71)	出魔人	000001	990					
(21) Дим н	•	10.52   0 250125		(11)	山腴ノ	•		<b>△</b> 4L				
(22)出顧日		₩ c					機株式		Lve	~ <del></del> .		
(22/四殿口		平成8年(1996)9月6日		(=0)				<b>永败</b> 2	上田 .	2 1 1	15番5号	
				(72)	発明者	'						
									<b>卜通</b> :	2丁[	35番5号	=
							株式会	社内				
				(72)	発明者	至 平野	均					
						大阪府	守口市	京阪2	▶通:	2丁[	35番5号	Ξ
						洋電機	株式会	社内				
				(72)	発明者	首 蔵本	慶一					
						大阪府	守口市	京阪2	<b>上通</b> :	2丁[	35番5号	三
				洋電機株式会社内								
				(74)	代理丿				(5	<b>1</b> 11	<u>ሄ</u> )	
						<del>-</del> -			•		-, 最終頁に	字く こうしょう
				1							AUT 34 161	<i>&gt;u</i> \

# (54) 【発明の名称】 硬質炭素被膜の形成方法及び電気シェーパー刃

# (57)【要約】

【課題】 電気シェーバーの外刃1及び内刃11などの 複雑な三次元形状の基板に対しても中間層2及び12を 均一に形成し、硬質炭素被膜3及び13を良好な密着性 で形成する。

【解決手段】 基板1及び11上に、メッキにより中間層2及び12を形成した後、この中間層2及び12の上に硬質炭素被膜3及び13を形成することを特徴としている。



(2)

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に硬質炭素被膜を形成する方法で あって、

前記基板上にメッキにより中間層を形成する工程と、 前記中間層の上に硬質炭素被膜を形成する工程とを備え る硬質炭素被膜の形成方法。

【請求項2】 基板上に硬質炭素被膜を形成する方法で あって.

電鋳法により型材の上に前記基板を析出させて形成する

前記基板上にメッキにより中間層を形成する工程と、 前記中間層の上に硬質炭素被膜を形成する工程とを備え る硬質炭素被膜の形成方法。

【請求項3】 前記中間層をメッキにより形成する工程 において、前記基板を前記型材上に保持した状態で前記 基板上に前記中間層を形成する請求項2に記載の硬質炭 素被膜の形成方法。

【請求項4】 前記基板の少なくとも表面が導電性を有 する請求項1~3のいずれか1項に記載の硬質炭素被膜 の形成方法。

【請求項5】 前記基板がNiまたはAlを主成分とす る金属もしくは合金、またはステンレス鋼からなる基板 である請求項1~4のいずれか1項に記載の硬質炭素被 膜の形成方法。

【請求項6】 前記基板が電気シェーバー刃の基板であ る請求項1~5のいずれか1項に記載の硬質炭素被膜の 形成方法。

【請求項7】 前記中間層がRu、Cr、Sn、及びC oからなるグループより選ばれる少なくとも1種の金属 またはこれを主成分とする合金からなる請求項1~6の 30 間層の上に硬質炭素被膜を形成する工程とを備えてい いずれか1項に記載の硬質炭素被膜の形成方法。

【請求項8】 前記中間層に、酸化物、窒化物、または 炭化物の微粒子が分散されている請求項1~7のいずれ か1項に記載の硬質炭素被膜の形成方法。

【請求項9】 請求項1~8のいずれか1項に記載の方 法に従い、基板上に中間層を介して硬質炭素被膜を形成 したことを特徴とする電気シェーバー刃。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気シェーバー刃 40 などに用いることができる硬質炭素被膜を有した基板の 形成方法及び該形成方法により得られる電気シェーバー 刃に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、基板上に直接ダイヤモンド状 被膜を形成すると、基板とダイヤモンド状被膜の密着性 が良好でないという問題があった。このような問題を解 決するため、基板とダイヤモンド状被膜との間に中間層 を形成させることが提案されている。特開平1-317

リコンを主成分とする中間層を形成し、この中間層の上 にダイヤモンド状被膜を形成する技術が開示されてい る。とのような中間層を設けるととにより、基板上に直 接ダイヤモンド状被膜を形成した場合に比べ、基板に対 するダイヤモンド状被膜の密着性を向上させることがで きる。

【0003】また、電気シェーバー刃等として用いられ るニッケル(Ni)、アルミニウム(Al)、及びステ ンレス鋼などの基板上にダイヤモンド状被膜を形成する 10 場合において、Ruを中間層として形成する技術が、特 開平7-41386号公報に開示されている。 このよう な中間層を形成することにより、基板上に直接ダイヤモ ンド状被膜を形成する場合に比べ、基板に対するダイヤ モンド状被膜の密着性を向上させることができる。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 従来技術において、中間層は、スパッタリング法やプラ ズマCVD法などの気相成長法により形成されている。 従って、基板の形状が複雑な三次元形状になると、膜厚 を厚くしたり、あるいは基板の配置状態を中間層の形成 工程の途中において変える等の必要を生じた。

【0005】本発明の目的は、複雑な三次元形状の基板 に対しても中間層を均一に形成することができかつ硬質 炭素被膜を良好な密着性で形成することができる硬質炭 素被膜の形成方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の硬質炭素被膜の 形成方法は、基板上に硬質炭素被膜を形成する方法であ り、基板上にメッキにより中間層を形成する工程と、中 る.

【0007】本発明に従う、より限定された局面におい ては、電鋳法により型材の上に基板を析出させて形成す る工程と、該基板上にメッキにより中間層を形成する工 程と、中間層の上に硬質炭素被膜を形成する工程とを備 えている。

【0008】さらに、この限定された局面においては、 中間層をメッキにより形成する工程において、基板を型 材上に保持した状態で基板上に中間層を形成することが できる。とのため、基板を型材から外す必要がなく、よ り高い生産性で製造することができる。

【0009】本発明における硬質炭素被膜は、非晶質の ダイヤモンド状被膜及び微結晶を含むダイヤモンド状被 膜を含むものである。さらには、結晶質のダイヤモンド 被膜を含むものである。

【0010】本発明において、硬質炭素被膜の形成方法 は、特に限定されるものではないが、例えばCVD法に より形成することができる。また例えば、プラズマCV D法を用い、基板に高周波電圧を印加し、これによって 197号公報では、プラズマCVD法により基板上にシ 50 基板に自己バイアス電圧を発生させながら硬質炭素被膜 を形成してもよい。このような場合、基板に発生させる自己バイアス電圧はー20V以下であることが好ましい。プラズマCVD法におけるプラズマ発生手段としては、例えば、電子サイクロトロン共鳴(ECR)プラズマCVD装置等を用いることができる。このような装置を用いることにより、プラズマの密度をさらに上げることができ、低温で高品質の硬質炭素被膜を形成することができる。

3

【0011】本発明において、中間層を形成するメッキ方法は、一般的なメッキ方法を採用することができ、電 10 気メッキ、無電解メッキなどを採用することができる。電気メッキにより中間層を形成する場合には、基板の少なくとも表面が導電性を有することが一般的には必要である。

【0012】本発明によれば、メッキにより中間層を形成するので、複雑な立体形状を有する基板に対しても、均一な厚みで中間層を形成することができ、従来の気相法による薄膜形成では付き回りの悪いエッジ部分等にも、均一に中間層を形成することができる。従って、硬質炭素被膜の基板に対する密着性を高めることができる。また、均一に中間層を形成することができるので、従来の気相法による中間層の形成に比べ、より薄い膜厚で中間層を形成することが可能になる。本発明における中間層の膜厚は、特に限定されるものではないが、50~5000人であり、さらに好ましくは100~3000人である。

【0013】本発明は、上述のように複雑な三次元形状を有する基板に対しても中間層を均一に形成することができる。従って、例えば電気シェーバー刃の外刃及び内刃のような複雑な三次元形状を有するものに対して、有 30利に適用することができる。電気シェーバー刃は、一般に、NiまたはAlを主成分とする金属もしくは合金、またはステンレス鋼などから形成されている。従って、本発明は、これらの基板に対して有利に適用することができるものである。

【0014】中間層の材料としては、メッキによって形成することができ、かつ基板と硬質炭素被膜との密着性を高めることができる材料であれば特に限定されるものではない。このような中間層の材料の具体例としては、例えば、Ru、Cr、Sn、及びCo等の金属、及びこ40れらを主成分とする合金などが挙げられる。

【0015】また、本発明における中間層は、メッキ被膜中に、セラミックなどの微細粒子を分散させた複合メッキにより形成されたものであってもよい。とのような複合メッキは、従来から一般に知られている方法により行うととができ、一般には微細粒子を分散させたメッキ浴中でメッキを行うことにより微細粒子を分散して含有したメッキ被膜を形成することができる。

【0016】とのような複合メッキ被膜中に分散させる 微細粒子としては、例えば、AI、Ru、Ti、Cr、 Sn、Co、Si、B、及びZrの酸化物、窒化物、及び炭化物などを挙げるととができる。分散メッキ被膜中の微細粒子の含有量は、 $0.1\sim30$ 体積%が好ましく、さらに好ましくは $1\sim10$ 体積%である。また微細粒子の粒子径は $1\mu$ m以下が好ましい。

4

【0017】本発明において、分散メッキ被膜を中間層として形成する場合には、メッキ被膜中の分散粒子が、硬質炭素被膜に対する密着性を向上させることができる。従って、メッキ被膜においてマトリクスとなる材料は、上記のメッキ膜材料よりも広い範囲から選択することができる。例えば、Ni基板を用いた場合に、基板と同じ材料であるNiを用いてメッキ被膜を形成し、このNiメッキ被膜中に微粒子を分散させることにより、硬質炭素被膜に対する密着性を向上させることができる。【0018】

【発明の実施の形態】図1は、本発明に従い硬質炭素被膜を形成した電気シェーバー刃の外刃及び内刃を示す断面図である。図1を参照して、電気シェーバー刃の外刃の基板1の上には、メッキにより形成された中間層2が形成されており、この中間層2の上に硬質炭素被膜としてのダイヤモンド状被膜3が形成されている。図2は、外刃の基板1の平面形状を示す平面図である。図2に示すように、多数のひげを捉えるための孔1aが形成されている。

【0019】図1を再び参照して、外刃の基板1の内側には、内刃が設けられており、内刃の基板11の上に、メッキにより形成された中間層12が形成され、との中間層12の上にダイヤモンド状被膜13が形成されている。内刃の基板11の先端部分には、ひげをより鋭く切断するための傾斜面11aが形成されている。外刃の孔1aに捉えられたひげは、その内側で図1に示す矢印の方向に摺動している内刃により切断される。図3は、内刃の基板11を示す正面図であり、図1の紙面に沿う方向から見た正面図である。図3に示すように、内刃の基板11の先端部に傾斜面11aが形成されている。

【0020】本実施例では、外刃の基板1はNiから形成され、内刃の基板11はステンレス鋼(SUS)から形成されている。図4は、電気シェーバーの外刃の基板1の上に、メッキにより中間層2を形成した状態を示す断面図である。電気シェーバーの外刃の基板は、例えば、電鋳法により形成することができる。

【0021】図5及び図6は、電鋳法により形成した外 刃の基板上に引き続きメッキにより中間層を形成する工程を示す断面図である。図5(a)に示すように、ブラスチック板21の上に、ニッケルメッキによりまたは銅箔を貼ることにより金属層22を形成する。次に図5(b)に示すように、金属層22の上にレジスト膜23を形成し、このレジスト膜23を電気シェーバーの外刃に対応する所定のパターンにパターニングした後、レジ50スト膜23をマスクとして金属層22をエッチングし、 (4)

電気シェーバーの外刃の所定のバターンに形成する。次 に、図5 (c) に示すように、レジスト膜を除去し、プラスチック板21の上に電気シェーバーの外刃のバターンにバターニングされた金属層22を得る。

【0022】次に、図6(d)に示すように、金属層22の上にニッケルメッキを施し、電鋳法により電気シェーバーの外刃の基板1を形成する。この電鋳法に使用するニッケルメッキ液は、一般的な電気メッキ液であり、例えば、塩化ニッケル30g/リットル、スルファミン酸ニッケル300g/リットル、硼酸30g/リットル、ピット防止剤適量などからなるメッキ液を用いることができる。また例えば、pH3.5~4.0、温度30~60℃、電流密度2~15A/dm²の条件で電気メッキを行い、ニッケル層を析出させることができる。析出させるニッケル層の厚みは特に限定されるものではないが、例えば約10~100μmの厚みで形成される。

【0023】次に、図6(e)に示すように、金属層22の上に外刃の基板1を保持したままの状態で、電気メッキまたは無電解メッキ等により、外刃の基板1の上に20中間層2を形成する。メッキ液としては、中間層として形成するメッキ膜の種類に応じ、一般的なメッキ液及びメッキ条件を採用することができる。この中間層2の膜厚としては、例えば約50~5000人の膜厚に形成される。

【0024】次に、図6(f)に示すように、金属層から外刃の基板1を剥離することにより、中間層を形成した電気シェーバーの外刃の基板が得られる。この中間層の上に、ダイヤモンド状薄膜などの硬質炭素被膜を形成することにより、外刃の基板の上に中間層を介して硬質炭素被膜を形成した電気シェーバーの外刃を得ることができる。なお、硬質炭素被膜の形成は、外刃の基板1を金属層から剥離せずに、外刃の基板1を金属層から剥離せずに、外刃の基板1を金属層22の上に保持したままの状態で行い、硬質炭素被膜形成後に、金属層から外刃の基板1を剥離してもよい。

# 【0025】実施例1

図5及び図6に示す電鋳法により、Niからなる電気シェーバー刃の外刃の基板を形成した後、この上にRuからなる中間層を形成した。電鋳法により基板を形成する際のNiメッキ液としては、塩化ニッケル30g/リットル、スルファミン酸ニッケル300g/リットル、硼酸30g/リットル、ピット防止剤適量からなるメッキ液を用い、pH3.5、温度50℃、電流密度10A/dm²の条件でメッキを行い、電鋳法によりNi基板を型材の上に析出させた。基板の厚みは約50μmとした

【0026】次に、基板を型材の上に保持したままの状態で、Ruメッキを行い、基板の上に中間層を形成した。Ruメッキ液としては、硫酸ルテニウム3g/リットル、硫酸6g/リットル、添加剤適量のものを用い、

p H約1.5、温度約50℃、電流密度2 A / d m の 条件でメッキを行った。中間層の厚みとしては約100 Aとした。

6

【0027】以上のようにしてNi基板上にRu中間層を形成した後、中間層の上にダイヤモンド状被膜を形成した。ダイヤモンド状被膜は、ECRプラズマCVD装置を用いて行った。薄膜形成条件としては、Arガス分圧5.7×10<sup>-1</sup>Torr、CH。ガス分圧1.3×10<sup>-1</sup>Torr、マイクロ波周波数2.45GHz、マイクロ波電力100Wで行った。基板ホルダーには高周波電源から13.56MHzのRF電力を印加し、基板に発生する自己バイアス電圧が一50VとなるようにRF電力を調整して印加した。15分間薄膜形成することにより、膜厚1000人のダイヤモンド状被膜が形成された。次にダイヤモンド状被膜を形成した後、基板を型材から剥離した。

## 【0028】実施例2

実施例1と同様にして型材の上にNi基板を形成した後、Snメッキを行い中間層を形成した。Snメッキ液としては、錫酸ナトリウム90g/リットル、水酸化ナトリウム8g/リットル、酢酸ナトリウム10g/リットルのメッキ液を用い、温度70℃、電流密度1.5A/dm²の条件でメッキを行った。中間層の厚みは約100Aとした。Sn中間層を形成した後、上記実施例1と同様にしてSn中間層の上にダイヤモンド状被膜を約1000Aの厚みとなるように形成した。

#### 【0029】実施例3

上記実施例1と同様にして型材上でNi基板を形成した 後、 $Sn \times y$  キ液中にSiC粒子を分散させた複合 $\times y$  キ液を用いて、中間層を形成した。 $Sn \times y$  キ液としては上記実施例2と同様のものを用い、 $Co \times y$  キ液中に粒径約0.1 $\mu$ mのSiC粒子を、10重量%分散させた複合 $\times y$  キ液を用いた。 $\times y$  キ条件は上記実施例2と同様にし、厚み約0.5 $\mu$ mの $\times y$  に粒子を分散した $\times y$  の $\times y$  になっていた。 $\times y$  になっていた。 $\times y$  には、 $\times y$  がの $\times y$  に対する有されていた。 $\times y$  に、上記実施例1と同様にして中間層の上にダイヤモンド状被膜を形成した。

#### 【0030】比較例1

10 上記実施例1と同様に型材の上でNi基板を形成した 後、中間層を形成せずに直接ダイヤモンド状被膜を上記 実施例1と同様にして形成した。

【0031】以上のようにして得られた実施例1~3及び比較例1について、ダイヤモンド状被膜の密着性を評価した。密着性の評価は、ビッカース圧子を用いた一定荷重(荷重=1kg)の押し込み試験により行った。サンブル数を50個とし、Ni基板上のダイヤモンド状被膜に剥離が発生した個数を数えて評価した。評価結果を表1に示す。

50 [0032]

7

【表1】

	実施例 1	実施例 2	実施例3	比較例1	
剁離発生数 (個)	0	0	0	4 3	

【0033】表1から明らかなように、本発明に従いメッキにより中間層を形成した実施例1~3は、比較例1 に比べ優れた耐剥離性を示しており、基板に対するダイヤモンド状被膜の密着性が良好であることがわかる。 【0034】実施例4

図1に示す電気シェーバーの内刃の基板上に電気メッキによりRuからなる中間層を形成した。図7に示すように、コーティング処理用治具14の上に内刃の基板11を直立させた状態でRuメッキを施した。Ruメッキ液及びメッキ条件は上記実施例1と同様にして行った。この結果、Ruからなる中間層は、基板11のエッジ部分においても均一に形成されているととが確認された。

## 【0035】比較例2

図7に示すような、内刃の基板11を治具14に対し直立した状態で、スパッタリング法によりRu中間層12を形成した。スパッタリングの条件としては、Arガス分圧 $1.5 \times 10^{-3}$  Torrとし、ターゲットとしてRuを用い、ターゲットに投入する電力を400 Wにして行った。中間層の膜厚が約100 Aとなるように形成した。形成した中間層を観察したところ、中間層の付き回りが悪く、エッジ部分での中間層の厚みが薄くなっていることがわかった。

#### 【0036】比較例3

図8に示すように、コーティング処理用治具14に対し、内刃の基板11を傾けて配置し、この状態で比較例2と同様にスパッタリング法によりRuからなる中間層12を形成し、形成途中で内刃の基板11を逆方向に傾斜させ、その後同様にして中間層を形成した。この結果、エッジ部分の中間層が薄くなく、全体としてほぼ均一な中間層を形成することができた。

【0037】以上の実施例4と比較例2及び比較例3との比較から明らかなように、本発明に従いメッキにより中間層を形成することにより、複雑な三次元形状の基板に対しても、付き回りがよく、均一な薄膜を形成することができることがわかる。従って、このような均一な中間層の上に硬質炭素被膜を形成することにより、基板に対し密着性の良好な硬質炭素被膜とすることができる。

【0038】上記実施例においては、電気シェーバーの外刃及び内刃の基板上にメッキにより中間層を形成し、 との上に硬質炭素被膜を形成する例を示したが、本発明 はこれに限定されるものではなく、その他の基板に対し ても適用され得るものである。また、上記実施例では、 電気メッキにより中間層を形成する例を示したが、本発 明においては、無電解メッキにより中間層を形成しても よい。

【0039】なお、本発明を電気シェーバーに適用する 場合、電気シェーバーの外刃及び内刃の一方にのみ適用 させてもよいことは言うまでもない。また、上記実施例 では電気シェーバーの外刃の外側にのみ中間層及び硬質 炭素被膜を形成しているが、外刃の内側にも中間層及び 硬質炭素被膜を形成してもよい。

#### [0040]

【発明の効果】本発明に従えば、中間層をメッキにより 形成することにより、電気シェーバーの外刃及び内刃な どのような複雑な三次元形状を有する基板に対しても、 中間層を均一に形成することができ、硬質炭素被膜を基 板に対し良好な密着性で形成することができる。

【0041】また、本発明において、電鋳法により型材上に基板を析出させて形成した後、この基板上に中間層 をメッキにより形成する場合には、基板を型材の上に保持したままの状態で、連続して中間層を形成することができ、製造工程を簡略化し、生産効率を高めることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に従い形成された一実施例の電気シェーバーの外刃及び内刃を示す断面図。

【図2】電気シェーバーの外刃の平面形状を示す平面 図。

【図3】電気シェーバーの内刃を示す正面図。

【図4】電気シェーバーの外刃の外側に中間層を形成した状態を示す断面図。

【図5】本発明に従い基板を電鋳法により形成した後、 基板上に中間層を形成する工程を示す断面図。

【図6】本発明に従い基板を電鋳法により形成した後、 基板上に中間層を形成する工程を示す断面図。

【図7】本発明に従う実施例においてメッキにより中間 層を形成するときの電気シェーバーの内刃の配置状態を 示す側面図

【図8】比較例において電気シェーバーの内刃の上にス の バッタリング法により中間層を形成する際の配置状態を 示す側面図。

# 【符号の説明】

1…電気シェーバーの外刃の基板

1a…電気シェーバー外刃の基板の孔

2…中間層

3…硬質炭素被膜

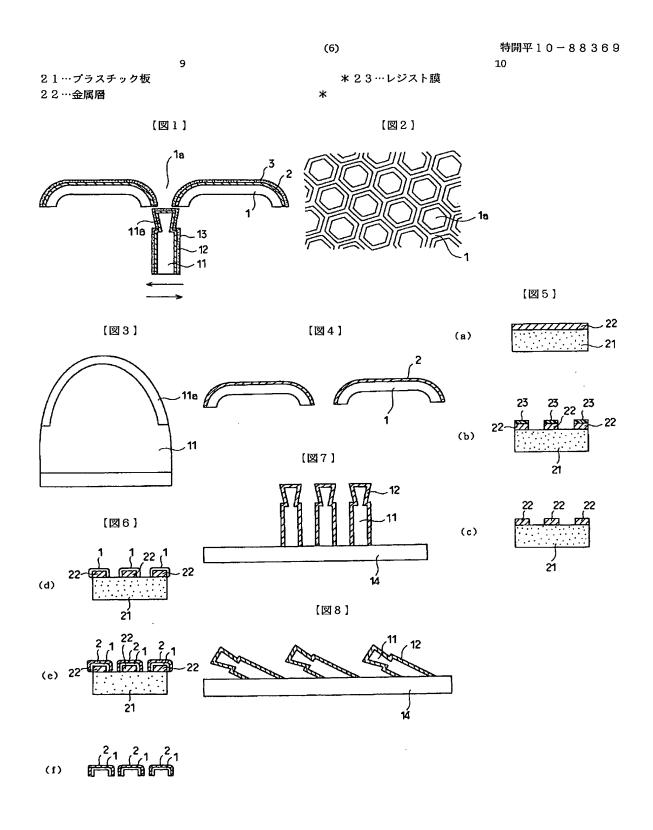
11…電気シェーバーの内刃の基板

11a…電気シェーバーの内刃の基板の外周部の傾斜面

12…中間層

50 13…硬質炭素被膜





(7)

特開平10-88369

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup> C 3 O B 29/04 識別記号

FΙ

C30B 29/04

В

(72)発明者 木山 精一

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

